

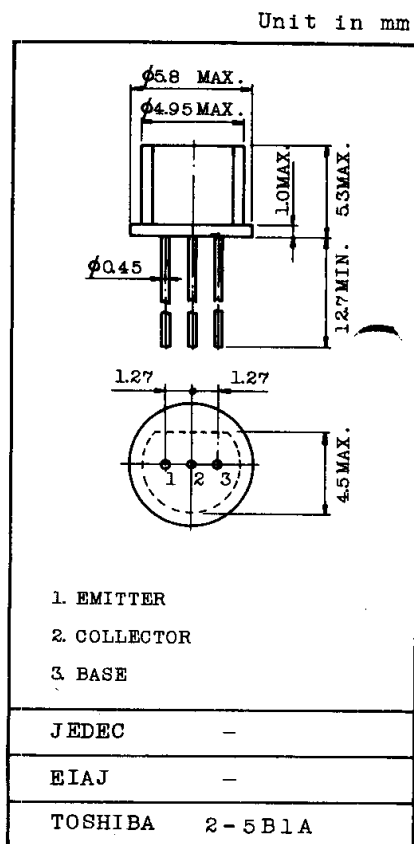
2SC383

シリコンNPNエピタキシャルプレーナ形トランジスタ SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR

- テレビ PIF 最終段増幅用
- TV Final Picture IF Amplifier Applications
- ・ 高利得です ; $G_{pe} = 33\text{dB (Typ.)}$ $f = 45\text{MHz}$
- ・ 小信号電流増幅率の直線性がよい。($f = 100\text{MHz}$)

最大定格 MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	75	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	40	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	3	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
エミッタ電流	I_E	-50	mA
コレクタ損失	P_C	300	mW
接合温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~125	$^\circ\text{C}$

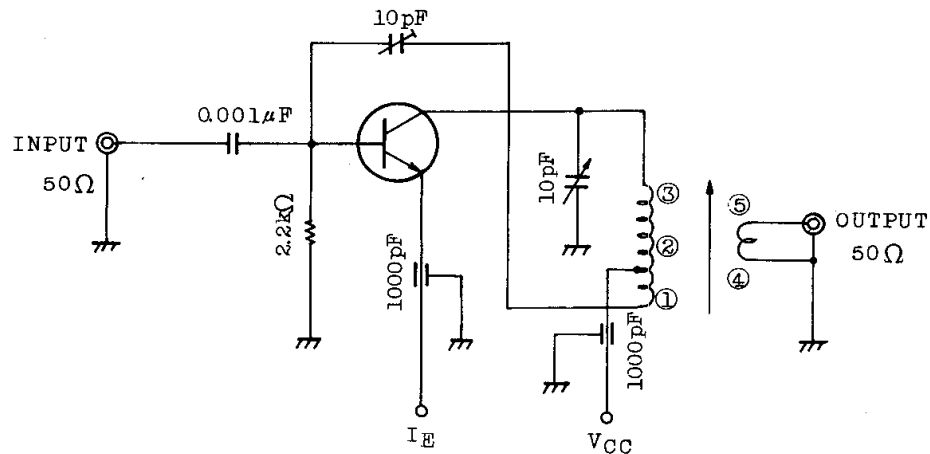


電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタ シャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=10V, I_E=0$	—	—	25	nA
エミッタ シャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=3V, I_C=0$	—	—	0.1	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10mA, I_B=0$	45	—	—	V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=12.5V, I_C=12.5mA$	20	—	100	
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0$ $f=1MHz$	0.8	—	2.0	pF
ベース拡がり抵抗	$r_{bb'}$	$V_{CE}=6V, I_E=-2mA$ $f=30MHz$	—	—	25	Ω
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=12.5V, I_E=-12.5mA$	300	—	—	MHz
電力利得 (Fig.1)	G_{pe}	$V_{CE}=12.5V, I_E=-12.5mA$ $f=45MHz$	29	—	36	dB
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=15mA, I_B=1.5mA$	—	—	0.2	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=15mA, I_B=1.5mA$	—	—	1.5	V

Fig.1 45MHz G_{pe} 測定回路

45 MHz G_{pe} TEST CIRCUIT



CALL DATA 0.35mm ϕ Cu WIRE L=1.2 μ H M-5 PUT IN USE

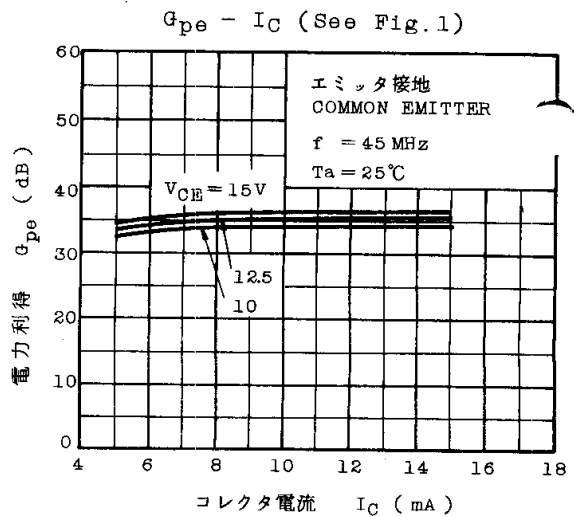
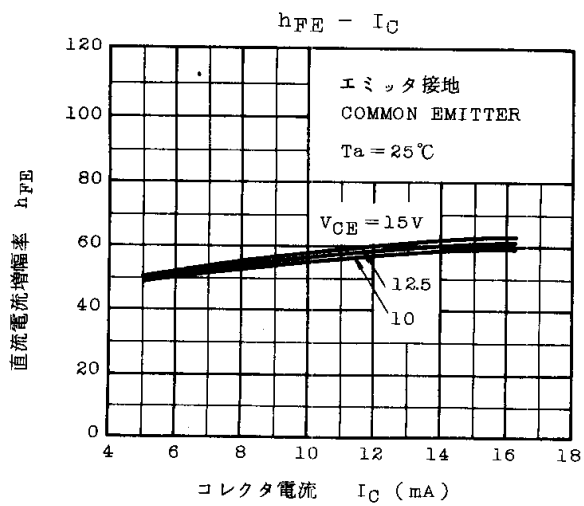
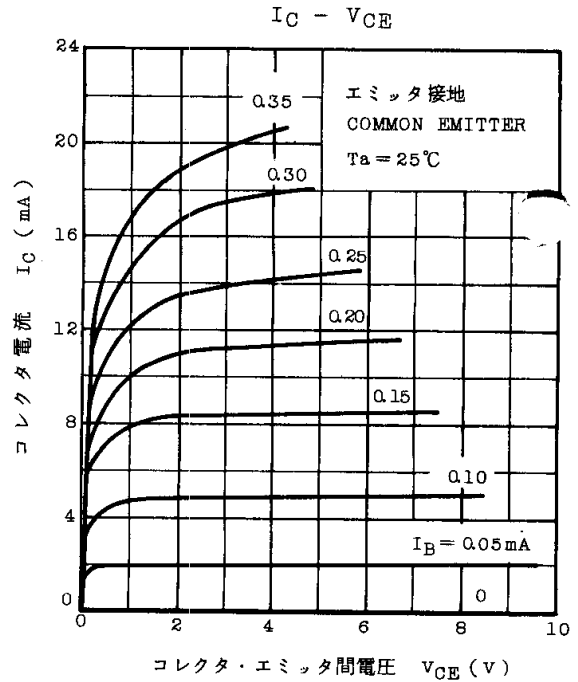
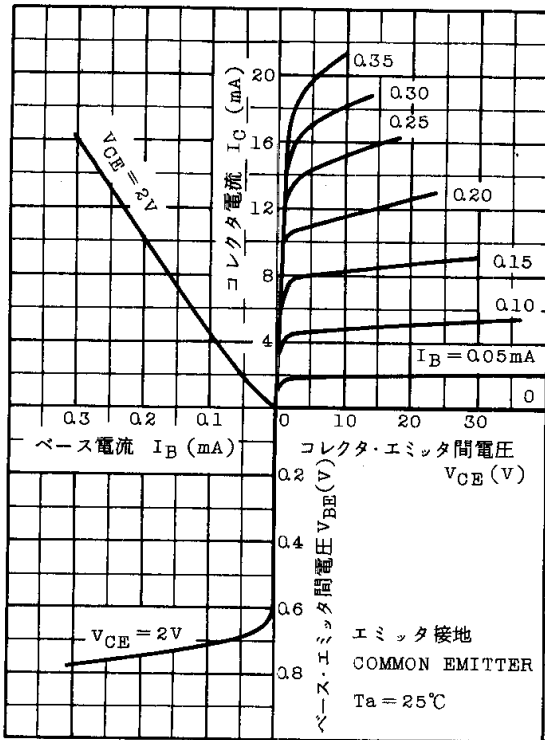
① - ② 3.0 T

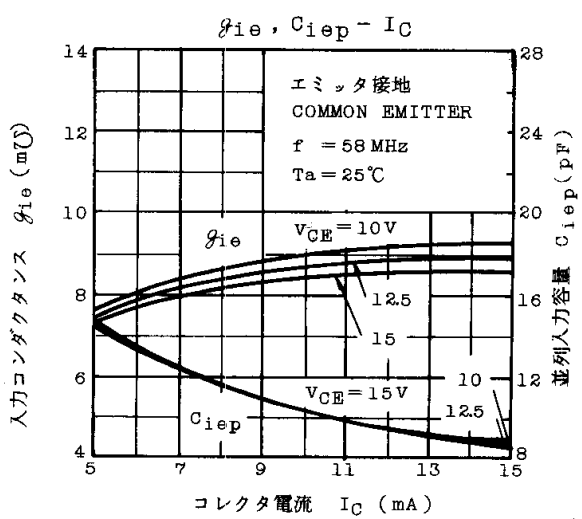
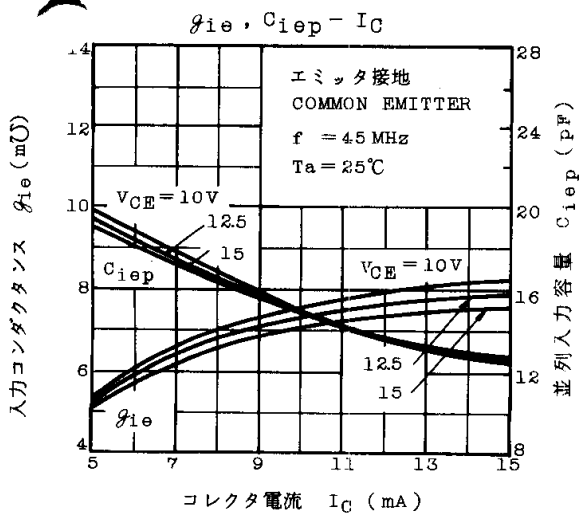
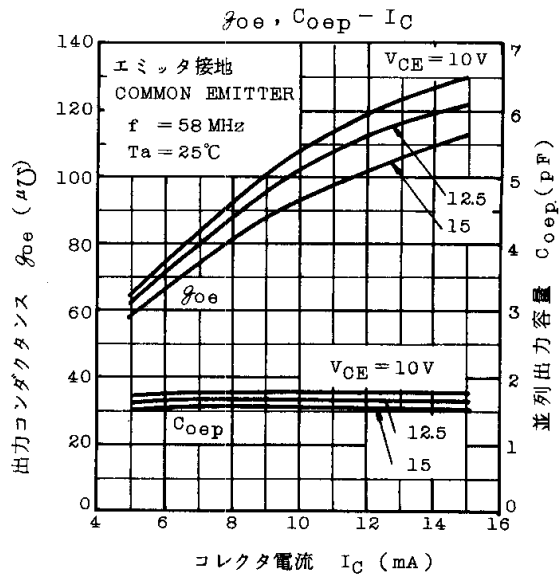
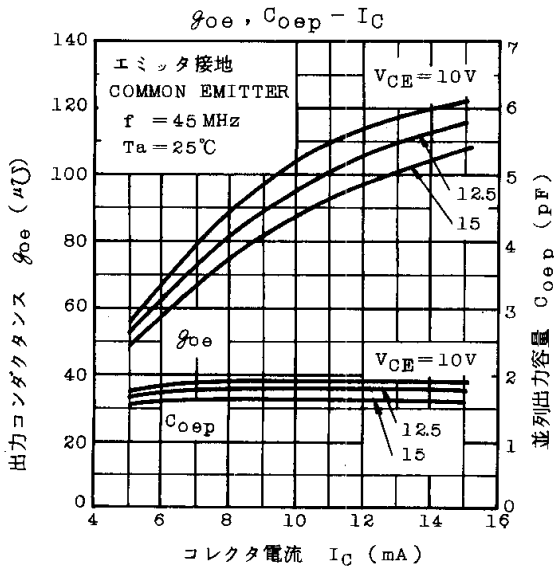
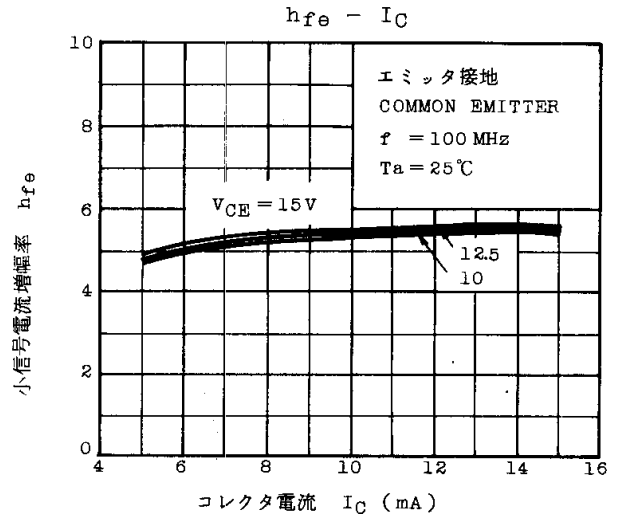
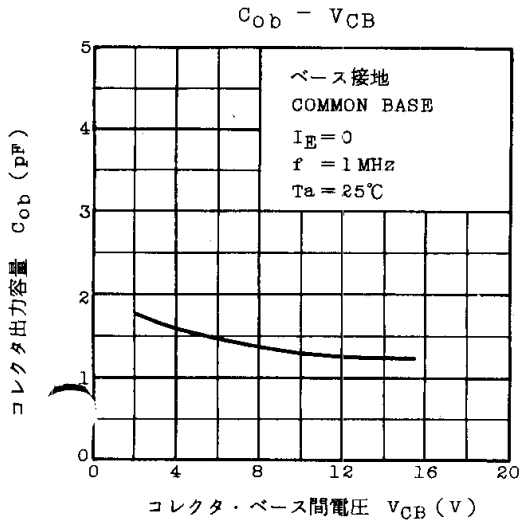
② - ③ 8.0 T

④ - ⑤ 1.0 T

2SC383

STATIC CHARACTERISTICS





2SC383

